
0.1. Introducción

En esta sección se implementó una compuerta **NOT** utilizando diversas tecnologías, siendo estas TTL (Transistor-Transistor-Logic), RTL (Resistor-Transistor-Logic) mediante transistores BJT (Bipolar Junction Transistor) y finalmente una variación de RTL utilizando un transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor).

0.2. Comparación tecnológicas.

Usaremos dos tipos de transistores, siendo estos BJT y MOSFET.

- Los BJT son controlados por corriente, mientras que los MOS son controlados por tensión.
- Los BJT tienen una respuesta mas veloz ante un cambio en su modo de funcionamiento¹ que los MOS dado a que poseen una menor capacidad.
- Los transistores MOS tienen una mayor estabilidad frente a la temperatura que los BJT.
- Los transistores BJT cuentan con una corriente de polarización de base que los MOS no tienen ($I_g = 0$).
- La impedancia de entrada de los MOS es mucho mayor que la de los BJT.

0.3. Circuitos Propuestos.

Los circuitos propuestos son los siguientes:

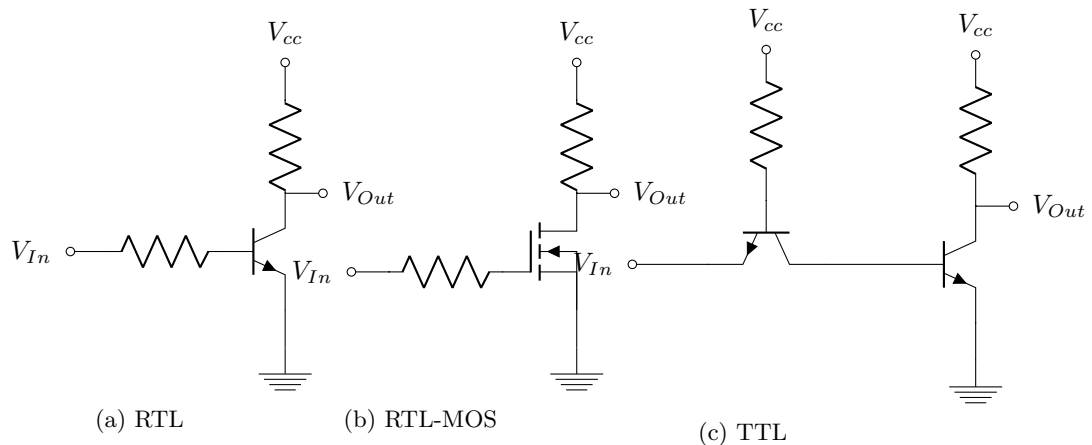


Figura 1: Circuitos propuestos

¹Saturación y corte

0.4. Diseño PCB.

Se implementó en un único PCB los 3 circuitos, que corresponden al siguiente esquemático:

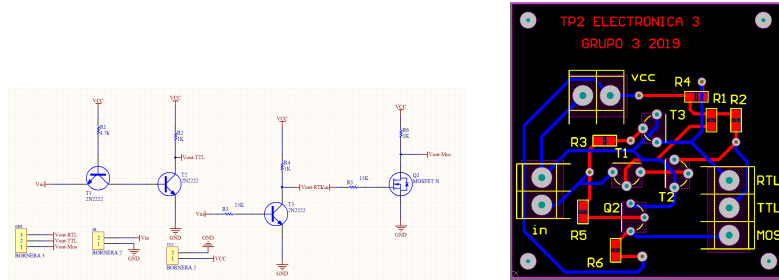


Figura 2: Esquemático y PCB.

0.5. Observables de interés.

Se seleccionaron como observables de interés los siguientes parámetros:

1. High-level input voltage
2. Low-level input voltage
3. High-level output voltage
4. Low-level output voltage
5. Noise Margin
6. Propagation delay High to Low
7. Propagation delay Low to High
8. Transition delay High to Low
9. Transition delay Low to High
10. Maximum output current

Las mediciones de estos observables se realizaron de la siguiente manera. Para las mediciones de $\langle \sigma_x \rangle$, $\langle \sigma_y \rangle$, $\langle \sigma_z \rangle$, $\langle \sigma_x^2 \rangle$ y $\langle \sigma_y^2 \rangle$ se utilizó una rampa la cual iba de un valor ligeramente inferior a 0V hasta 5 V, la razón de esto, es que dado a que se utilizó una rampa, contiene un salto en el cambio de periodos el cual contiene altas frecuencias y puede causar problemas, agregando ese pequeño tiempo en el cual la tensión es menor a 0V se alcanza a estabilizar la señal. La figura (??) es un ejemplo de una de las mediciones.

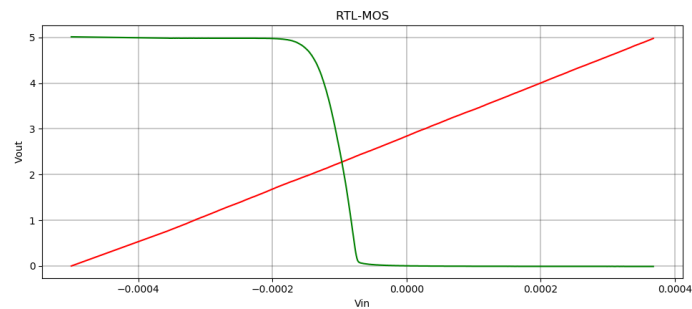


Figura 3: Medición niveles de tensión.

A partir de esta medición, se tomó el módulo de las señales y se graficó la señal de entrada en función de la salida, como se ve a continuación.

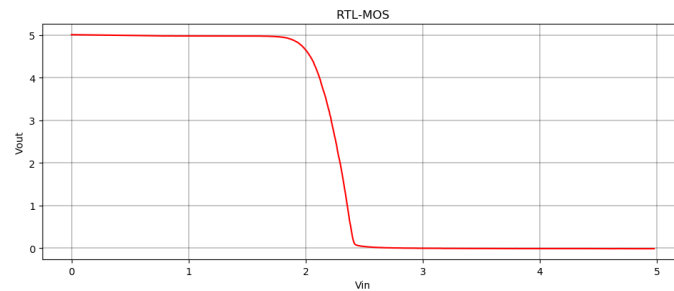


Figura 4: Medición entrada-salida.

finalmente a partir de esta imagen se buscó donde la pendiente es 45° , de allí se obtuvo (??), (??), (??) y (??), realizando la resta de (??) con (??), y de (??) con (??) se obtienen los márgenes de ruido (??).

Luego para (??),(??),(??) y (??) se midió la salida, con una cuadrada a la entrada como se ve en la siguiente figura:

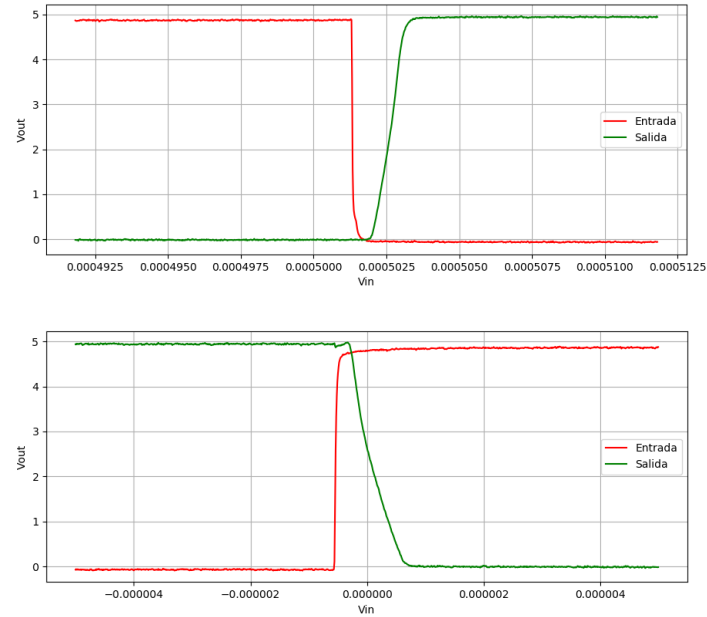


Figura 5: Medición tiempo de propagación y transición.

Tomando el tiempo de propagación medido al 50 % de la señal y el tiempo de transición medido entre el 10 ~ 90 %. Para la medición del tiempo de propagación existe una medición la cual dio un valor menor al tiempo de rise del osciloscopio, este resultado debe ser interpretado una cota del tiempo y no el valor exacto.

Finalmente se colocó un trimmer de $50k\Omega$ utilizandolo como carga, se varió su impedancia hasta que el valor de tensión de la salida se encuentre por debajo del High Level output Voltage. A partir de este valor de tensión y la resistencia del trimmer, se obtiene la corriente máxima de salida.

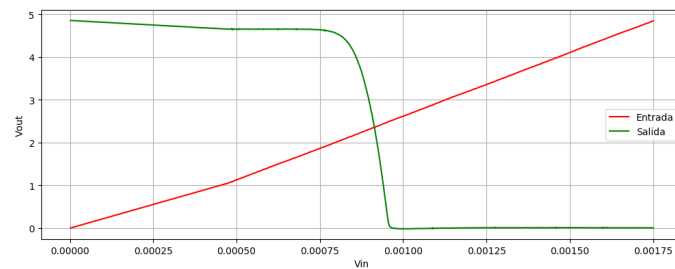


Figura 6: Medición corriente máxima de salida.

0.6. Análisis de resultados.

Para realizar una comparación entre los modelos propuestos, se utilizarán los observables de interés definidos en la sección (??) utilizando la siguiente tabla:

<i>Sin carga</i>			
Tecnología	RTL	RTL-MOS	TTL
High-level input voltage	864 mV	2.49 V	595 mV
Low-level input voltage	454 mV	1.95 V	413 mV
High-level Output voltage	4.96 V	4.89 V	4.96 V
Low-level Output voltage	191 mV	72.1 mV	34.5mV
Noise Margin High	4.01 V	2.34 V	4.37 V
Noise Margin Low	263 mV	1.88 V	378 mV
Propagation delay High to Low	76.93 nS	569.51 nS	1.82 nS
Propagation delay Low to High	2.0489 μS	1.33 μS	535 nS
Transition delay High to Low	87.28 nS	734.4 nS	38.36 nS
Transition delay Low to High	605 nS	909 nS	307 nS
Maximum output current	184.4 μA	217 μA	135.5 μA

<i>Con carga</i>			
Tecnología	RTL	RTL-MOS	TTL
High-level input voltage	840 mV	2.48 V	627.5 mV
Low-level input voltage	478.7 mV	2.01 V	490 mV
High-level Output voltage	4.98 V	4.86 V	4.95 V
Low-level Output voltage	278 mV	151 mV	72 mV
Noise Margin High	4.14 V	2.52 V	4.32 V
Noise Margin Low	200.7 mV	514.9 mV	417.3 mV
Propagation delay High to Low	260.7 nS	625.7 nS	33.6 nS
Propagation delay Low to High	2.615 μS	1.652 μS	1.216 μS
Transition delay High to Low	183.817 nS	417.19 nS	73.12 nS
Transition delay Low to High	2.691 μS	2.831 μS	2.687 μS
Maximum output current	187.2 μA	216 μA	135.2 μA

Las diferencias entre los parámetros para las tres tecnologías son notables,

TOMI AUXILIO
